## Диэлектрические и оптические свойства жидкого кристалла 5-пропил-2-(п-цианфенил)-пиридин

© Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия

E-mail: belyaev@iph.krasn.ru

(Поступила в Редакцию 17 июля 2002 г.)

Вблизи фазового перехода из нематического в изотропное состояние исследованы температурные зависимости диэлектрических и оптических характеристик жидкого кристалла 5-пропил-2-(п-цианфенил)-пиридин. В диапазоне частот 1–1000 MHz для твердой кристаллической, нематической и изотропной фаз измерены диэлектрические спектры, а также проведены их дебаевские аппроксимации. По зависимости статической диэлектрической проницаемости от направления директора относительно электрического поля накачки установлено, что дипольный момент малекулы отклонен от ее продольной оси на угол ~ 15°.

Авторы выражают признательность Российскому фонду фундаментальных исследований за поддержку работы (грант № 00-03-32206).

Как известно, частотная дисперсия диэлектрической проницаемости является одним из основных свойств жидких кристаллов (ЖК). Изучение характера дисперсии и особенно ее изменения под воздействием различных факторов — важная задача не только прикладной, но и фундаментальной физики. Как правило, область дисперсии, обусловленная релаксацией молекул ЖК, ограничивается частотами метрового диапазона длин волн и в настоящее время для многих жидкокристаллических сред достаточно хорошо изучена. Одако существует ряд ЖК, для которых высокочастотные диэлектрические свойства почти не изучены, так как их частоты релаксации попадают в дециметровый диапазон длин волн, где диэлектрические измерения с требуемой точностью связаны с большими трудностями. К таким материалам, в частности, относится нематический ЖК 5-пропил-2-(п-цианфенил)-пиридин (ЗСР), структурная формула молекулы которого приведена на рис. 1. Исследования оптических и диэлектрических свойств этого нематика представляют большой интерес в связи с тем, что его молекулы близки по структуре к молекулам хорошо известных и подробно изученных ЖК из серии алкилцианобифенилов *n*-CB (*n* = 5–9) [1–5]. Отличие состоит лишь в том, что в жестком остове молекулы ЗСР в одном из двух бензольных колец атом углерода замещен азотом. Кроме того, молекула ЗСР имеет низкое для ЖК число метиленовых секторов в алкильном "хвосте" (n = 3). Температура фазового перехода этого соединения из твердого кристаллического состояния в жидкую нематическую фазу  $t_0 = 43.5^{\circ}$ С, а температура перехода из нематической фазы в неупорядоченную изотропную жидкость  $t_c = 47.4^{\circ}$ С.

Целью данной работы является экспериментальное исследование температурных и частотных зависимостей диэлектрической проницаемости, определение коэффициентов оптического преломления, а также проведение численных аппроксимаций диэлектрических спектров, полученных для различных фазовых состояний ЖК 5-пропил-2-(п-цианфенил)-пиридин в диапазоне частот f = 1-1000 MHz.

Измерение диэлектрических проницаемостей в области частот 1-30 MHz проводилось на стандартном измерителе добротности фирмы "Tesla" BM560 с использованием измерительной ячейки в виде плоского конденсатора. В метровом и дециметровом диапазонах длин волн применялись резонансные высокочувствительные микрополосковые датчики кольцевого типа [6]. Дискретная перестройка датчиков с малым шагом осуществлялась с помощью калиброванных индуктивностей и электрически управляемых емкостей (варакторов), подключаемых в разрыв полоскового проводника в области пучности сверхвысокочастотного (СВЧ) магнитного поля для первой моды колебаний микрополоскового резонатора [7]. В пучности СВЧ-электрического поля резонатора располагалась емкостная измерительная ячейка, изготовленная в виде встречно-штыревой структуры с зазором между штырями 150 µm. Образец ЖК толщиной 200 µm помещался непосредственно на встречноштыревую структуру, ограниченную стеклянным бордюром, и защищался от загрязнения фторопластовой пленкой. Такие датчики позволяют снимать диэлектрические спектры с высокой точностью, несмотря на сравнительно малый объем исследуемого образца.

Измерение действительной компоненты диэлектрической проницаемости  $\varepsilon'$  осуществлялось стандартным способом путем регистрации сдвига частоты датчика с образцом относительно частоты пустого датчика, а мнимая компонента диэлектрической проницаемости  $\varepsilon''$  вычислялась по изменению нагруженной доброт-



Рис. 1. Структурная формула жидкого кристалла 5-пропил-2-(п-цианфенил)-пиридин.

ности резонатора после размещения в нем образца ЖК. Амплитудно-частотные характеристики микрополосковых датчиков регистрировались автоматическим измерителем комплексных коэффициентов передачи Р4-37. При этом абсолютная точность определения диэлектрических характеристик была не хуже  $\delta \varepsilon' \sim 0.05$  и  $\delta \varepsilon'' \sim 0.1$ . Требуемый угол  $\varphi$  наклона длинных осей молекул образца ЗСР относительно направления СВЧ-электрического поля в измерительной ячейке устанавливался ориентацией постоянного магнитного поля H = 2500 Ое. Измерения проводились в термостате в температурном интервале от  $0-50^{\circ}$ С. Точность стабилизации температуры была не хуже  $0.1^{\circ}$ С.

Измерения температурных зависимостей оптических показателей преломления для обыкновенного  $n_0$  и необыкновенного  $n_e$  лучей проводились на длине волны света  $\lambda = 0.589 \,\mu$ m с использованием рефрактометра ИРФ-454 Б при гомеотропной ориентации директора в измерительной ячейке.

На рис. 2 представлены результаты измерений температурных зависимостей показателей оптического преломления (темные символы) для обыкновенного  $n_0$  (1) и необыкновенного n<sub>e</sub> (2) лучей. Здесь же показаны зависимости от температуры действительных компонент диэлектрических проницаемостей (светлые символы): продольной  $\varepsilon'_{\parallel}(3)$  и поперечной  $\varepsilon'_{\perp}(4)$ , снятых соответственно при параллельной и перпендикулярной ориентации директора молекул ЖК относительно электрического поля накачки. Скорость нагрева исследуемого образца задавалась ~ 4°C/h. Измерение диэлектрических констант проводилось на частоте накачки f = 1 MHz, где частотная дисперсия еще практически не проявляется. Поэтому полученные диэлектрические характеристики близки к соответствующим статическим значениям  $\varepsilon'_{||0}$ и  $\varepsilon'_{10}$ . Как и следовало ожидать, при температуре перехода ЖК из нематической в изотропную фазу  $(t_c - t = 0)$  оптические и диэлектрические константы изменяются скачком. При этом как в нематической фазе (кривые 1-4), так и в изотропном состоянии (5, 6)



**Рис. 2.** Температурные зависимости оптических (темные символы) и диэлектрических (светлые символы) характеристик жидкого кристалла 3СР в области фазового перехода нематик– изотропная жидкость.



**Рис. 3.** Зависимость диэлектрической проницаемости образца 3СР от угла направления директора молекул относительно высокочастотного поля накачки.

наблюдаются слабые зависимости измеренных констант от температуры.

На рис. 3 показаны зависимости действительной компоненты диэлектрической проницаемости исследуемого образца в нематической фазе от угла между направлением ориентирующего молекулы ЖК постоянного магнитного поля Н и направлением высокочастотного электрического поля. Эти измерения также проводились вне области дисперсии образца на частоте накачки  $f = 1 \, \text{MHz}$ . Хорошо видно, что полученная зависимость асимметрична относительно вертикальной линии, проведенной через точку  $\phi = 90^{\circ}$ . При этом значении угла длинные оси молекул ориентированы ортогонально полю накачки. Наблюдаемая асимметрия  $\varepsilon'(\phi)$  свидетельствует, очевидно, об отклонении дипольного момента молекулы  $\mu$  от ее продольной оси. Угол этого отклонения несложно определить по величине смещения минимума зависимости  $\varepsilon'(\phi)$  относительно 90°; он составляет  $\beta \approx 15^{\circ}$ .

Отметим, что достаточно большие значения статических диэлектрических проницаемостей образца ЗСР ( $\varepsilon'_{\parallel 0} \approx 25$ ,  $\varepsilon'_{\perp 0} \approx 14.4$ ) и его диэлектрической анизотронии ( $\Delta \varepsilon' = \varepsilon'_{\parallel 0} - \varepsilon'_{\perp 0} = 11.4$ ) указывают на значительную величину дипольного момента молекул. Хорошо известно [1–4], что в ЖК группы алкилцианбифенилов *n*-CB, в которых дипольный момент  $\mu = 4.3$  D обусловлен циангруппой  $-C \equiv N$ , типичные значения диэлектрических констант для всех гомологов (n = 5-9) не превышают  $\varepsilon'_{\parallel 0} = 15-17$ ,  $\varepsilon'_{\perp 0} = 6-8$  и  $\Delta \varepsilon' = 8-9$  при температурах  $+1 < (t_c - t) < +5^{\circ}$ С. Все это свидетельствует о том, что благодаря существованию пиридиновой группы в молекуле ЖК ЗСР ее дипольный момент возрастает на 40–50% по сравнению с ЖК из серии алкилцианобифенилов.

На рис. 4 приведены частотные зависимости действительной компоненты диэлектрической проницаемости исследуемого образца 3СР, измеренные для различных состояний мезофазы. Кривая 1 получена при  $t = 0^{\circ}$ С и соответствует твердой кристаллической фазе; 2 и 3 из-



**Рис. 4.** Частотные зависимости диэлектрической проницаемости жидкого кристалла 3СР, снятые при различных температурах образца. t = 0 (1), 45 (2, 3) и 49°С (4).

мерены в нематической фазе ЖК при  $t = 45^{\circ}$ С и показывают соответственно дисперсию  $\varepsilon'_{\parallel}$  и  $\varepsilon'_{\perp}$ , а кривая 4 снята при  $t = 49^{\circ}$ С, когда образец находится в изотропном состоянии. Как видно, в твердой фазе дисперсия практически отсутствует, а величина диэлектрической проницаемости  $\varepsilon'_{s} = 2.63 \pm 0.02$ . Интересно отметить, что это значение проницаемости хорошо совпадает с величиной квадрата коэффициента оптического преломления для жидкой "высокотемпературной" изотропной фазы исследуемого ЖК  $n_{is}^2 = 2.624$ . Это свидетельствует о том, что в твердой кристаллической фазе ориентационный вклад вращения дипольного момента в диэлектрическую проницаемость отсутствует, а наблюдаемая величина  $\varepsilon'_{s}$  обусловлена малоинерционными процессами смещения внутримолекулярных электрических зарядов.

Для описания частотной дисперсии продольной (параллельной)  $\varepsilon'_{\parallel}(f)$  и поперечной (перпендикулярной)  $\varepsilon'_{\perp}(f)$  диэлектрической проницаемости образца 3СР, находящегося в нематической фазе, нами использовались различные подходы. При аппроксимации параллельной компоненты принимался во внимание тот факт, что дипольный момент молекулы отклонен на угол  $\beta$  от ее длинной оси. Поэтому в соответствии со сложившимися представлениями о механизмах диэлектрической поляризации ЖК [1–4,8] использовалось описание дисперсии с помощью суммы двух дебаевских процессов, отличающихся временами релаксации [9],

$$\varepsilon'_{\parallel}(f) - n_e^2 = \frac{(\varepsilon'_{\parallel 0} - n_e^2)g_1}{1 + \omega^2 \tau_{\parallel 1}^2} + \frac{(\varepsilon'_{\parallel 0} - n_e^2)g_2}{1 + \omega^2 \tau_{\parallel 2}^2}, \qquad (1)$$

где  $n_e$  — показатель оптического преломления для необыкновенного луча,  $\varepsilon'_{\parallel 0}$  — значение статической диэлектрической проницаемости,  $\omega = 2\pi f$ ,  $\tau_{\parallel 1}$  и  $\tau_{\parallel 2}$  времена релаксации двух процессов,  $g_1$  и  $g_2$  — соответствующие весовые множители процессов, сумма которых  $g_1 + g_2 = 1$ .

Существование двух релаксационных процессов в исследуемом ЖК обусловлено отклонением дипольного момента молекулы от ее продольной оси. Благодаря этому отклонению поперечная компонента  $\mu$  вносит некоторую добавку в продольную диэлектрическую проницаемость, и наоборот. Численная аппроксимация результатов измерения  $\varepsilon'_{\parallel}(f)$ , проведенная по формуле (1), показана кривой *I* на рис. 5. Кривая построена при следующих параметрах ЖК:  $\varepsilon'_{\parallel 0} = 25.2$ ,  $\tau_{\parallel 1} = 5 \cdot 10^{-9}$  s,  $\tau_{\parallel 2} = 3.8 \cdot 10^{-10}$  s,  $n_e = 1.7$ ,  $g_1 = 0.78$  и  $g_2 = 0.22$ .

Видно, что предлагаемая аппроксимация дает достаточно хорошее совпадение расчетной дисперсии параллельной диэлектрической проницаемости с экспериментальными данными во всем исследованном диапазоне частот. Кривая 2 на рис. 5 соответствует дисперсионной зависимости при  $g_1 = 1$  и  $g_2 = 0$ , которая согласуется с экспериментом лишь на "низких" частотах в самом начале области дисперсии. Кривая 3 соответствует дисперсионной зависимости при  $g_1 = 0$  и  $g_2 = 0.22$ , которая, напротив, достаточно хорошо согласуется с экспериментом только на "высоких" частотах в конце области дисперсии. И наконец, кривая 4 отвечает значению  $n_{e_r}^2$ , к которому приближается продольная диэлектрическая проницаемость исследуемого ЖК при  $f \to \infty$ .

Следует отметить, что времена  $\tau_{\parallel 1}$  и  $\tau_{\parallel 2}$  характеризуют дипольную релаксацию при вращении молекулы вокруг ее короткой и длинной осей. Отношение весовых множителей  $g_2/g_1$  отвечает тангенсу угла отклонения дипольного момента от длинной оси молекулы, который оказывается равным  $\beta = 15.7^{\circ}$ . Как видно, это значение хорошо совпадает с величиной угла  $\beta \approx 15^{\circ}$ , найденной из угловых измерений диэлектрической проницаемости (рис. 3).

Аппроксимация одним и даже двумя релаксационными дебаевскими процессами поперечной диэлектрической проницаемости ЖК, для которых частота релаксации при перпендикулярной накачке выше, чем при параллельной, как правило, показывает недостаточно хорошее совпадение с экспериментом. Наблюдаемое увеличение



**Рис. 5.** Результаты численной аппроксимации частотной зависимости продольной диэлектрической проницаемости суммой двух дебаевских процессов с различными временами релаксации.

![](_page_3_Figure_1.jpeg)

Рис. 6. Аппроксимация частотной зависимости поперечной диэлектрической проницаемости дебаевским процессом с непрерывным распределением времен релаксации.

расхождения с ростом частоты измеренного спектра  $\varepsilon'_{+}(f)$  (точки на рис. 6) и дебаевской зависимости с одним временем релаксации (кривая 2) позволяет предположить, что в ЖК на высоких частотах проявляются мелкомасштабные колебания подвижных алкильных групп молекул. В таких случаях времена диэлектрической релаксации удобно представлять в виде их непрерывного распределения в определенном интервале. При этом диэлектрический спектр описывается следующим выражением [9]:

$$\varepsilon_{\perp}'(f) - n_0^2 = \left(\varepsilon_{\perp 0}' - n_0^2\right) \int_0^\infty \frac{G(\tau)}{1 + (2\pi f \,\tau)^2} \, d\tau, \quad (2)$$

где n<sub>0</sub> — показатель оптического преломления для обыкновенного луча,  $G(\tau)$  — функция распределения времен релаксации. Для аппроксимации  $\varepsilon'_{\perp}(f)$  нами использовалась удобная для практических расчетов функция распределения, предложенная Фрелихом [10],

$$G(\tau) = \frac{kT}{u_0} \frac{1}{\tau}, \quad \tau_0 \le \tau \le \tau_1 = \tau_0 \exp(u_0/kT),$$
  

$$G(\tau) = 0, \quad \tau_1 \le \tau \le \tau_0,$$
(3)

где *u*<sub>0</sub> — граничная энергия, определяющая интервал, в котором равномерно распределены изменения высоты потенциальных барьеров диполей  $0 \leq \delta u \leq u_0$ . Особенностью этой функции распределения является ее зависимость от температуры. При этом относительная ширина интервала распределения времен релаксации  $(\tau_1 - \tau_0)/\tau_0$  уменьшается с повышением температуры; эта зависимость может быть представлена в виде

$$\frac{\tau_1 - \tau_0}{\tau_0} = \exp(u_0/kT) - 1.$$
 (4)

После интегрирования (2) в пределах от  $\tau_0$  до  $\tau_1$ с учетом (3) частотная зависимость действительной компоненты поперечной диэлектрической проницаемости принимает вид

c'(f)

$$\times \left[ 1 - \frac{kT}{2u_0} \ln \left( \frac{1 + \omega^2 \tau_0^2 \exp(2u_0/kT)}{1 + \omega^2 \tau_0^2} \right) \right].$$
(5)

Результаты численной аппроксимации, проведенной в соответствии с формулой (5), показаны на рис. 6 кривой 1, которая практически совпадает с экспериментальными точками. Здесь же кривой 3 показан уровень  $n_0^2$ , к которому приближается поперечная диэлектрическая проницаемость исследуемого ЖК при  $f \to \infty$ . Кривая 1 построена при следующих параметрах:  $\dot{\epsilon}'_{0\perp} = 14.4, T = 318 \text{ K}, u_0 = 1.52 \cdot 10^{-14} \text{ erg}, n_0 = 1.55, \tau_0 = 1.85 \cdot 10^{-10} \text{ s}$  in  $\tau_1 = 2.39 \cdot 10^{-9} \text{ s}$ . Отметим, что относительная ширина интервала непрерывного распределения времен релаксации в данном случае оказывается сравнительно небольшой  $(\tau_1 - \tau_0)/\tau_0 \approx 10$ . Однако полученные данные следует рассматривать как предварительные, так как частотный диапазон измерений в настоящей работе был недостаточно широк. Для уточнения параметров аппроксимации необходимы экспериментальные данные, охватывающие всю область дисперсии. Кроме того, как показывают эксперименты, в высокочастотной области дисперсии на диэлектрических спектрах ЖК могут наблюдаться и резонансные особенности [11], которые также необходимо принимать во внимание при аппроксимации  $\varepsilon'(f)$  [12]. Необходимо заметить, что для кривой 2 на рис. 6, построенной по уравнению Дебая с одним временем релаксации, равным  $\tau_D = 9 \cdot 10^{-10}$  s, это значение т<sub>D</sub> попадает почти в середину интервала  $(\tau_1 - \tau_0).$ 

Аппроксимация частотной зависимости диэлектрической проницаемости для неупорядоченной изотропной фазы кристалла ЗСР была проведена также на основе соотношений (2) и (3), поскольку наличие непрерывного распределения времен релаксации в изотропной фазе вполне допустимо. Хорошее совпадение аппроксимации с экспериментом получено при следующих параметрах ЖК:  $\varepsilon'_{0is} = 19.3$ , T = 322 K,  $u_0 = 2.28 \cdot 10^{-13}$  erg,  $n_i = 1.6$ ,  $\tau_0 = 2.1 \cdot 10^{-10}$  s и  $\tau_1 = 6.12 \cdot 10^{-9}$  s. Из сравнения этих значений с соответствующими величинами для ЖК в нематической фазе видно, что на порядок возросла величина ио и заметно изменилась врехняя граница диапазона времен релаксации, что привело к увеличению относительной ширины интервала  $(\tau_1 - \tau_0)/\tau_0$  более чем в 2 раза.

Таким образом, в данной работе измерены диэлектрические проницаемости в различных фазовых состояниях ЖК 5-пропил-2-(п-цианфенил)-пиридин в широком диапазоне частот и температур. Обнаружено существенное отклонение направления дипольного момента от длинной оси молекулы, угол которого составляет  $\beta \approx 15^{\circ}$ . Установлено, что частотная зависимость продольной проницаемости  $\varepsilon'_{\parallel}(f)$  ЖК в нематической фазе с хорошей точностью описывается суммой двух дебаевских процессов, различающихся временами релаксации. Показано, что для аппроксимации поперечной  $\varepsilon'_{\perp}(f)$  в нематической фазе и диэлектрической проницаемости ЖК в изотропном состоянии  $\varepsilon'_{is}(f)$  в формулах Дебая требуется учитывать непрерывное распределение времен релаксаций в определенном интервале. Выявлено хорошее совпадение характера температурных зависимостей статических диэлектрических проницаемостей и коэффициентов оптического преломления в области фазового перехода жидкокристаллический нематик-изотропная жидкость.

## Список литературы

- D.A. Dunmur, M.R. Manterfield, W.H. Miller, J.K. Dunleavy. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 45, 127 (1978).
- [2] P.G. Gummins, D.A. Dunmur, D.A. Laidler. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 30, 109 (1975).
- [3] B.R. Ratna, R. Shashidar. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 42, 185 (1977).
- [4] J.M. Wacrenier, C. Druon, D. Lippens. Mol. Phys. 43, 97 (1981).
- [5] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов, В.Н. Шепов. ФТТ 42, 5, 956 (2000).
- [6] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Н. Шепов. ЖТФ 65, 2, 189 (1995).
- [7] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов, В.Н. Шепов. ЖТФ 72, 4, 99 (2002).
- [8] Л.М. Блинов. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов. Наука, М. (1978). 384 с.
- [9] А.А. Потапов, М.С. Мицек. Диэлектрическая поляризация. Изд-во Иркут. ун-та, Иркутск (1986). 264 с.
- [10] Г. Фрелих. Теория диэлектриков. ИЛ, М. (1960). 249 с.
- [11] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов, В.Н. Шепов. Письма в ЖЭТФ 66, 4, 251 (1997).
- [12] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов, В.Н. Шепов. ФТТ 42, 3, 564 (2000).